

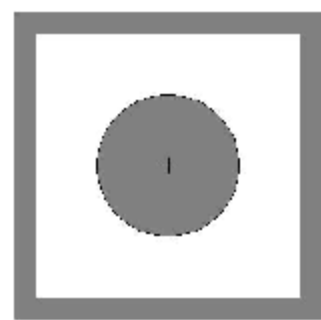
1504

硅外延平面二极管芯片（4"）

■特征:

- *较小结电容
 - *正向压降低
 - *用于片式封装
- *输出电流：200 mA
 - *功率耗散 P_D ：350 mW
 - *有效图形数：78900

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	300 μ m $\times$ 300 μ m
压焊区尺寸	ϕ 130 μ m
芯片厚度	180 $\pm$ 10 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面：Al 2.3 $\pm$ 0.2 μ m 背面：Au 1.4 $\pm$ 0.2 μ m

■电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单位
击穿电压	V_R	$I_R=5\text{ }\mu\text{ A}$	210		270	V
正向压降	$V_F(1)$	$I_F=1\text{ mA}$		0.80	0.74	V
	$V_F(2)$	$I_F=10\text{ mA}$		0.90	0.83	V
	$V_F(3)$	$I_F=50\text{ mA}$		1.00	0.92	V
	$V_F(4)$	$I_F=100\text{ mA}$		1.10	0.96	V
	$V_F(5)$	$I_F=200\text{ mA}$		1.30	1.04	V
	$V_F(6)$	$I_F=300\text{ mA}$		1.50	1.12	V
反向漏电流	$I_R(1)$	$V_R=125\text{ V}$		10		nA
	$I_R(2)$	$V_R=180\text{ V}$		40		nA
总电容	C_T	$V_R=0, f=1\text{ MHz}$		4		PF